### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

#### (43) 国際公開日 2005年8月11日(11.08.2005)

PCT

# (10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2005/072853 A1

B01D 53/68, B01J 20/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/000907

(22) 国際出願日:

.

2005年1月25日(25.01.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-020976 2004年1月29日(29.01.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 大陽 日酸株式会社 (TAIYO NIPPON SANSO CORPORA-TION) [JP/JP]; 〒1428558 東京都品川区小山一丁目 3番26号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長谷川 英晴

(HASEGAWA, Hideharu) [JP/JP]; 〒1428558 東京都品 川区小山一丁目3番26号 大陽日酸株式会社内 Tokyo (JP). 石原 良夫 (ISHIHARA, Yoshio) [JP/JP]; 〒 1428558 東京都品川区小山一丁目3番26号大陽 日酸株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 克昌 (SUZUKI, Katsumasa) [JP/JP]; 〒1428558 東京都品川区小山一丁目 3番26号 大陽日酸株式会社内 Tokyo (JP).

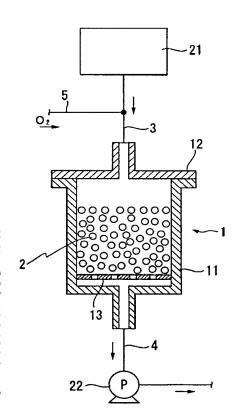
(74) 代理人: 志賀正武, 外(SHIGA, Masatake et al.); 〒 1048453 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

/続葉有/

(54) Title: EXHAUST GAS TREATING AGENT, METHOD FOR TREATING EXHAUST GAS AND APPARATUS FOR TREATING EXHAUST GAS

(54) 発明の名称: 排ガス処理剤および排ガス処理方法ならびに排ガス処理装置



(57) Abstract: Disclosed is an exhaust gas treating agent which is composed of a granular porous calcium oxide whose surface is partially composed of a calcium hydroxide. The exhaust gas treating agent preferably has a surface area of not less than 1 m<sup>2</sup>/g and a porosity of 10-50 volume%. The calcium oxide is obtained by firing a granular calcium carbonate. The exhaust gas discharged from a semiconductor manufacturing apparatus, which is still in the gaseous state, is brought into contact with this exhaust gas treating agent, thereby causing a reaction of a harmful gas component in the exhaust gas and removing it.

本発明の排ガス処理剤は、粒状で、多孔質であり、そ の表面の一部が水酸化カルシウムとなっている酸化カルシウムから なる排ガス処理剤である。表面積が1m²/g以上であり、空間率が 10~50体積%であることが好ましい。この酸化カルシウムは、 粒状の炭酸カルシウムを焼成して得られたものであり、半導体製造 装置から排出される排ガスを気体状のまま、この排ガス処理剤に接 触させて有害ガス成分を反応させて除去する。

### WO 2005/072853 A1

NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。